

Nachhaltige Cleaning-Chemie für die Halbleiterproduktion

GreenClean - Intelligent Fluid - IFTiN

Projektinformationen

Projektvolumen | EUR 240.000

Projektlaufzeit | 01.09.2025 - 31.10.2025

intelligent fluids GmbH, Leipzig Projektpartner |

Fraunhofer IPMS, Dresden



- Erdölbasiert & Lösungsmittel
- Reprotoxizität bzw. starke Hautgängigkeit Hohe Anwendungstemperaturen
- Aggressiv gegenüber Equipment & Material Sehr hoher Entsorgungsaufwand
- 10-80% Water ■ 2-20% Surfactant 5-20% Oil ■ 1-10% Smart activators > 1% Other substances
- Wasserbasiert
- Schont Material & Equipment Niedrige Anwendungstemperatur
- Patentierte Phasenfluid-Technologie

auf Mikroemulsionsbasis

Ziele & Beschreibung, Vorgehen & Methodik

Ziel: Ersatz kritischer Cleaning-Chemie in repräsentativ industriellem Use-Case auf 300mm-Tool, Benchmarking und Ökobilanzierung anhand eines Referenzprozesses.

anwendun Cleaning Chemie Tool/ Prozess

Anforderungen an Cleaning-Chemie in CMOS:

- Filterkompatibilität im Tool, ideale Vorbereitung der Oberfläche auf nächsten Prozessschritt
- mind. VLSI Grade
- <u>Use-Case HF-Ersatz</u>: im basischen zum Schutz des Oxids, darf TiN nicht angreifen
- Use-Case EKC-Ersatz: im basischen zum Schutz von Cu und/oder Oxid, idealerweise TiN ätzend, mischbar mit H₂O₂



Prio 1: Partikelperformance-Tests auf TiN, Cu und Si, blank und strukturiert

Prio 2: Atzangriff und CD-Treue auf TiN, Cu und Resiste evaluiert

Ätzraten

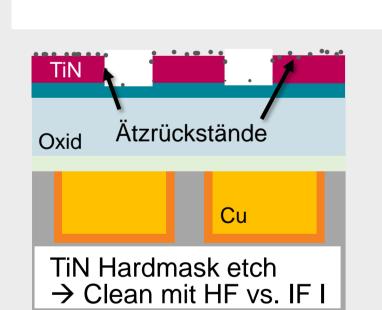
(blank)

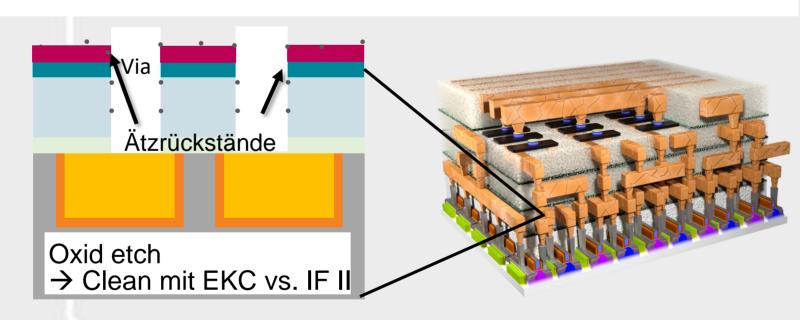
- Prio 3: Post TiN Etch Residue removal → HF-Ersatz?
- Prio 4: Post TEOS Etch Residue removal → EKC-Ersatz?

Technologie & Anwendungsfelder

In der Verdrahtungsherstellung im BEOL oder der Strukturierung anderer Metallisierungen ist das Cleaning einer der wesentlichen Schritte in der Mikroelektronik, zB zur Entfernung von Ätzrückständen, und muss vielfach wiederholt werden.

Bei bis zu 13 Cu-Level übereinander ist es einer der wichtigsten Reinigungsschritte bei Halbleiter-Bauelementen.





Partikeltests (blank)

auf Si und TiN

I+II Chemien

- Je mit Verschiedene Referenz (HF, EKC) und IF
 - Resiste Je mit
 - Referenz (HF, EKC) und IF

I+II Chemien

TiN und Cu

- Blank, geschädigte Resiste
- geätzt, strukturiertes TiN mit versch.
- Resisten Je mit Referenz (HF) und IF I Chemie

Residuen TiN

TEOS etch

Entfernung

Residuen

- Geätztes TEOS mit TiN Hartmaske und versch. Resisten Je mit Referenz
- (EKC) und IF II Chemie
- Bilanzierung dHF + DIW

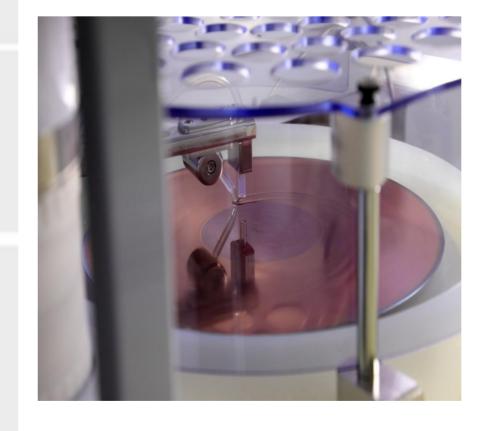
Öko-

- EKC + H2O2 • IF I + SC1
- IF II + H₂O₂ Energieverbrauch,

Entsorgung,

Wartung

Innovation & Zukunftsperspektive



Auf HF- und EKC basierende Cleaning-Chemie bringen enormen Entsorgungsaufwand und Gefahrstufe mit sich.

IF-Chemie muss nicht gesondert entsorgt werden und bildet keine Gefahr für Umwelt und Mensch.

- Marktpotenzial PR-Strip, MLO & CCC:
- Weltweit: 3,2 Mrd. €
- Europa: ca. 320 Mio. €

Ansprechpersonen

Fraunhoer IPMS: Dr. Katharina Lilienthal Matthias Rudolph Philipp Schramm

Intelligent fluid GmbH:

Dr. Ronny Tepper (Fluid Design,

Anwendungstechnik)

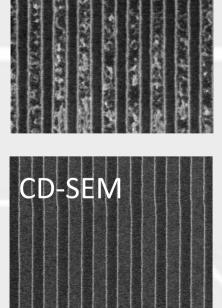
Dr. Salem Nasraoui (Teamleiter Mikroelektronik)

Dr. Matthias Golecki (Regulatory, Nachhaltigkeit)

Bisherige Ergebnisse & Erkenntnisse 4

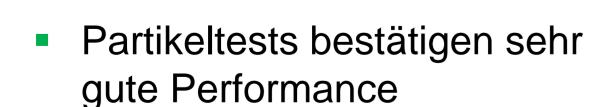
Patterned Defects

post etch post clean



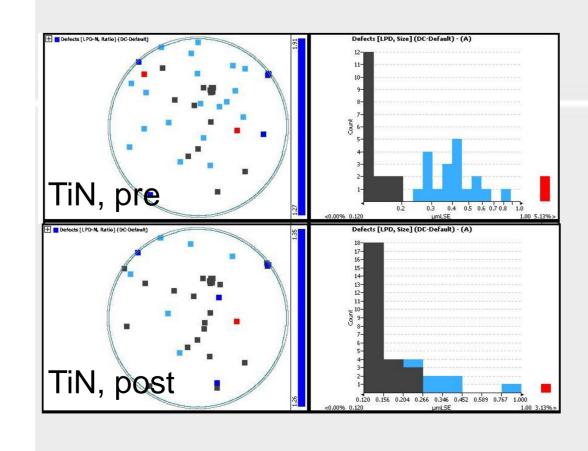
HF (Ref) 408 Neg 516 -21% 1300 -19% IF I 1609 Neg Pos 1277 -38% HF (Ref) -45% Pos 2237 1225 IF I

Post wet clean CAN Probe 1: links: HF, rechts IF I



Resist

- Patterned Defect Inspection bestätigt vergleichbare **Defect-Performance** von IF I vs. HF-clean
- CD-SEM Messungen bestätigen CD-Treue



Reduktion

Chemie



Gefördert durch:

